

Prof. Dr. Doris Schmitt-Landsiedel

Mitglied des Aufsichtsrats der
Infineon Technologies AG seit 2005



Persönliche Daten

Geburtsdatum: 13. Dezember 1952

Nationalität: deutsch

Ausbildung

- 1984 Promotion (Dr. rer. nat.), Technische Universität München
- 1980 Diplom-Abschluss im Fach Physik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- 1977 Diplom-Abschluss im Fach Elektrotechnik,
Universität Fridericiana Karlsruhe (TH)
- 1971 – 1980 Studium der Elektrotechnik und Physik,
Universitäten Karlsruhe und Freiburg

Beruflicher Werdegang

- Seit 1996 Professorin und Lehrstuhlinhaberin, Lehrstuhl für Technische Elektronik, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität München (TUM)
- 1983 – 1996 Diverse (leitende) Positionen im Bereich Forschung und Entwicklung, Siemens AG (München)
Forschungsschwerpunkte: High-Speed-CMOS und -BICMOS Schaltungen (digital und analog); Ultralow Power CMOS Circuits für Hörgeräte; statische, dynamische und nichtflüchtige Speicher; Ausbeute-Monitoring von CMOS-Prozessen
- 1981 – 1983 Promotionsstipendium, Central R&D, Siemens AG (München)

Sonstige Mitgliedschaften und Ämter (Auswahl)

- 2008 - 2014 Mitglied des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
- 2004 – 2010 Mitglied des deutschen Wissenschaftsrats
- 2001 – 2007 Sprecherin der Forschergruppe „Selected Materials, Processes and Devices for Ultra-large-scale Integrated Circuits“, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)